

# 2014年(平成26年) 第75回応用物理学会秋季学術講演会 講演募集要項

●登壇申込【電子投稿】締切：2014年6月12日(木)17:00(厳守)  
URL：<http://meeting.jsap.or.jp/entry.html>

●会合(IM)申込締切：2014年6月20日(金)(厳守)

## 開催期日・場所

期 間:2014年9月17日(水)~20日(土)

場 所:北海道大学札幌キャンパス  
(北海道札幌市北区北8条西5丁目)

## ご注意

現在, 応用物理学会では分科の再編・統合を進めております. 機関誌「応用物理」4月号掲載の募集要項から大分類・中分類分科の番号・名称が変更されておりますので, 登壇申込の画面でよくご確認いただき, 手続きして下さい.

## 大分類 3, 4, 5 の編成

従来の大分類 3, 4, 5 の統合・再編が行われ, 大分類分科名称・番号, 中分類分科名称・番号が春季講演会より大幅に変更されております. ご投稿の際には, 必ず大分類名, 中分類名をご確認ください.

## コードシェアセッション

今大会からの新たな試みとして, 投稿締切り後のプログラム編成委員会において, 複数中分類間での合同セッションが企画できるようになりました. このため, ご投稿時に希望された中分類ではなく, 他の中分類とのコードシェアセッションに講演がプログラムされる可能性があります.

なお, すでにコードシェアセッション開催が決まっているものについては, 募集要項内の大分類・中分類表にその旨記載がございます.

## 参加予約申込

一般講演を行うに当たっては, 会員登録に伴い発生する入会金・年会費のほかに「講演会参加費」が必要になります. 事前予約申込(8月25日締切)をご利用いただきますと, 当日価格と比べ最大40%割引となります. 大会公式ホームページ、または会員システム・マイページの「講演会参加予約申込」からお申込みいただけますので是非ご利用下さい(5月23日より受付開始予定).

なお, 未納の会費がある場合にはお支払いが確認でき次第, 参加予約申込が可能になります. まだ会費のお支払いがお済みでない場合には, お早めにお支払いをお願いいたします.

## JSAP-OSA Joint Symposia 2014 について

アメリカ光学会 (OSA) とのジョイントシンポジウムを開催します. 本ジョイントシンポジウムでの発表はすべて英語となります. 詳細は大会公式ホームページを御覧下さい.

## 1.一般講演の募集

応用物理学に関する学術成果について、表1～3に示す常設分科、合同セッション、シンポジウムに関する一般講演を募集します。なお、講演日・講演分科はプログラム編集委員会にて決定します。

### ご注意

従来の大分類3, 4, 5の統合・再編が行われ、大分類分科名称・番号、中分類分科名称・番号が春季講演会より大幅に変更されております。ご投稿の際には、登壇申込の画面でよくご確認いただき、手続きして下さい。

表1.常設分科 Regular categories

大分類分科名 Category	中分類分科名	Section
1 応用物理学一般 Applied Physics in General	1.1 応用物理一般・学際領域	Interdisciplinary and general physics
	1.2 教育	Education
	1.3 新技術・複合新領域	Novel technologies and frontier engineering science
	1.4 エネルギー変換・貯蔵	Energy conversion and storage
	1.5 資源・環境	Resources and environment
	1.6 磁場応用	Magnetic field and its application
	1.7 計測技術・計測標準	Instrumentation and measurement, metrology
	1.8 超音波	Ultrasonic
2 放射線 Ionizing Radiation	2.1 放射線物理一般・検出器基礎	Radiation physics and detectors
	2.2 検出器開発	Detection systems
	2.3 放射線応用・発生装置・新技術	Application of radiation, radiation generators and technologies
3 光・フォトンクス Optics and Photonics	3.1 光学基礎・光学新領域	Basic optics and frontier of optics
	3.2 材料・機器光学	Materials and equipment optics
	3.3 情報フォトンクス・画像工学	Information photonics and image engineering
	3.4 生体・医用光学	Biomedical optics
	3.5 レーザー装置・材料	Laser devices and materials
	3.6 超高速・高強度レーザー	Ultrashort-pulse and high-intensity lasers
	3.7 レーザープロセッシング	Laser processing
	3.8 光計測技術・機器	Optical measurement technology and devices
	3.9 テラヘルツ全般	THz technology
	3.10 量子子物理・技術	Optical quantum physics and technologies
	3.11 フォトニック構造・現象	Photonic structures and phenomena
	3.12 ナノ領域光科学・近接場光学	Nanoscale optical science and near-field optics
	3.13 半導体光デバイス	Semiconductor optical devices
	3.14 光制御デバイス・光ファイバ	Optical control devices and optical fiber
	3.15 シリコンフォトンクス	Silicon photonics
6 薄膜・表面 Thin Films and Surfaces セッションの一部をEnglishSessionとして開催: 6.4	6.1 強誘電体薄膜 9.1とコードシェアセッションで開催 (セッション名: 誘電体および強誘電体 ～薄膜・バルク～)	Ferroelectric thin films
	6.2 カーボン系薄膜	Carbon-based thin films
	6.3 酸化物エレクトロニクス	Oxide-based electronics
	6.4 薄膜新材料 English Session	New thin-film materials
	6.5 表面物理・真空	Surface physics and vacuum
	6.6 プローブ顕微鏡	Probe microscopy
7 ビーム応用 Beam Technology and Nanofabrication	7.1 X線技術	X-ray technologies
	7.2 電子顕微鏡, 評価, 測定, 分析	Electron microscopes, evaluation, measurement and analysis
	7.3 リソグラフィ	Lithography
	7.4 ナノインプリント	Nanoimprint
	7.5 ビーム・光励起表面反応	Particle/photon-beam-induced surface reactions
	7.6 イオンビーム一般	Ion beams
	7.7 微小電子源	Vacuum nanoelectronics and electron sources
	7.8 ビーム応用一般・新技術	New beam-application technologies
8 プラズマエレクトロニクス Plasma Electronics 8.1～8.6の全中分類を対象としたEnglish Sessionを設 けません。発表言語を「英語」とされた方をEnglish Sessionに割り当てようプログラム編集する予定で す。	8.1 プラズマ生成・制御	Plasma production and control
	8.2 プラズマ診断・計測	Plasma measurements and diagnostics
	8.3 プラズマ成膜・表面処理	Plasma deposition of thin film and surface treatment
	8.4 プラズマエッチング	Plasma etching
	8.5 プラズマナノテクノロジー	Plasma nanotechnology
	8.6 プラズマ現象・新応用・融合分野	General plasma phenomena, emerging area of plasmas and their new applications
9 応用物性 Applied Materials Science	9.1 誘電材料・誘電体 6.1とコードシェアセッションで開催 (セッション名: 誘電体および強誘電体 ～薄膜・バルク～)	Dielectrics, ferroelectrics
	9.2 ナノワイヤ・ナノ粒子	Nanowires, nanoparticles
	9.3 ナノエレクトロニクス	Nanoelectronics
	9.4 熱電変換	Thermoelectric conversion
	9.5 新機能材料・新物性	New functional materials and new physical properties
10 スピントロニクス・マグネティクス Spintronics and Magnetism 英語による講演を強く推奨し、優れた学生の英語講演 に対して、スピントロニクス研究会より奨励賞が贈ら れます。	10.1 新物質創成(酸化物・ホイスラー・金属磁性体等)	Creation of new materials
	10.2 スピントルク・スピン流・回路・測定技術	Spin torque, spin current, circuits, and measurement technologies
	10.3 GMR・TMR・磁気記録技術	Giant magnetoresistance (GMR), tunnel magnetoresistance (TMR) and magnetic recording technologies
	10.4 半導体・有機・光・量子スピントロニクス	Semiconductors, organic, optical, and quantum spintronics

11 超伝導 Superconductivity	11.1	基礎物性	Fundamental properties
	11.2	薄膜, 厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長	Thin films, thick films, coated conductors and thin film crystal growth
	11.3	臨界電流, 超伝導パワー応用	Critical current, superconducting power applications
	11.4	アナログ応用および関連技術	Analog application and its related technologies
	11.5	接合, 回路作製プロセスおよびデジタル応用	Junction, circuit fabrication process and digital applications
12 有機分子・バイオエレクトロニクス Organic Molecules and Bioelectronics  2014年春に中分類が再編されておりますので、ご確認のうえご投稿ください。	12.1	作製・構造制御	Fabrications and Structure Controls
	12.2	評価・基礎物性	Characterization and Materials Physics
	12.3	機能材料・萌芽のデバイス	Functional materials and novel devices
	12.4	有機EL・トランジスタ	Organic light-emitting devices and organic transistors
	12.5	有機太陽電池	Organic solar cells
	12.6	ナノバイオテクノロジー	Nanobiotechnology
	12.7	医用工学・バイオチップ	Medical engineering and biochips
13 半導体A(シリコン) Semiconductors A (Silicon)  2014年春に中分類が再編されておりますので、ご確認のうえご投稿ください。	13.1	基礎物性・表面界面現象・シミュレーション	Basic Properties, Surface and Interface Phenomena, and Simulation
	13.2	絶縁膜技術	Insulator technology
	13.3	Siプロセス・配線・MEMS・集積化技術	Si process, interconnect, MEMS, integration
	13.4	デバイス/集積化技術	Devices/Integration Technologies
	13.5	Si-English Session	Si-English Session
14 半導体B(探索的材料・物性・デバイス) Semiconductors B (Exploratory Materials, Physical Properties, Devices)	14.1	探索的材料物性	Physical properties of exploratory materials
	14.2	超薄膜・量子ナノ構造	Ultrathin films and quantum nanostructures
	14.3	電子デバイス・プロセス技術	Electron devices and Process technology
	14.4	光物性・発光デバイス	Optical properties and light-emitting devices
	14.5	化合物太陽電池	Compound solar cells
15 結晶工学 Crystal Engineering	15.1	バルク結晶成長	Bulk crystal growth
	15.2	II-VI族結晶および多元系結晶	II-VI-group crystals and multicomponent crystals
	15.3	III-V族エピタキシャル結晶	III-V-group epitaxial crystals
	15.4	III-V族窒化物結晶	III-V-group nitride crystals
	15.5	IV族結晶, IV-IV族混晶	IV-group crystals and IV-IV-group mixed crystals
	15.6	IV族系化合物	IV-group-based compounds
	15.7	エピタキシーの基礎	Fundamentals of epitaxy
	15.8	結晶評価, 不純物・結晶欠陥	Crystal evaluation, impurities and crystal defects
16 非晶質・微結晶 Amorphous and Microcrystalline Materials	16.1	基礎物性・評価	Fundamental properties and their evaluation in disordered materials
	16.2	プロセス技術・デバイス	Processing technologies and devices
	16.3	シリコン系太陽電池	Bulk, thin-film and other silicon-based solar cells
17 ナノカーボン Nanocarbon Technology	17.1	成長技術	Growth technology
	17.2	構造制御・プロセス	Structural control and process
	17.3	新機能探索・基礎物性評価	Exploration of new functions and evaluation of basic properties
	17.4	デバイス応用	Device application
18 JSAP-OSA Joint Symposia すべてEnglish Session	18.1	Plasmonics	Plasmonics
	18.2	Bio- and Medical Photonics	Bio- and Medical Photonics
	18.3	Laser Manufacturing	Laser Manufacturing
	18.4	Optical Micro-sensing, Manipulation, and Fabrications	Optical Micro-sensing, Manipulation, and Fabrications
	18.5	Opto-electronics	Opto-electronics
	18.6	Information Photonics	Information Photonics
	18.7	Laser Photonics – XFEL and ultrafast optics –	Laser Photonics – XFEL and ultrafast optics –
	18.8	Carbon Photonics	Carbon Photonics

※一般セッションからシンポジウムに回ることがございますのでご了承下さい。

※今大会からの新たな試みとして、投稿締切り後のプログラム編成委員会において、複数中分類間での合同セッションが企画できるようになりました。このため、ご投稿時に希望された中分類ではなく、他の中分類とのコードシェアセッションに講演がプログラムされる可能性があります。

表 2. 合同セッション Joint sessions

合同セッションK 「ワイドギャップ酸化半導体材料・デバイス」 Joint Session K "Wide bandgap oxide semiconductor materials and devices"	薄膜・表面の6.3酸化物エレクトロニクス, 6.4薄膜新材料, および結晶工学15.2 II-VI族結晶および多元系結晶で企画した合同セッションです。	This is a joint session of 6.3 Oxide-based electronics, 6.4 New thin film materials in 6. Thin Films and Surfaces and 15.2 II-VI-group crystals and multicomponent crystals in 15. Crystal Engineering.
--	---	---

表 3.シンポジウム Symposiums

一般講演の投稿論文を受け付けいたします。ただし、御希望に添えず「表 1. 常設分科」, 「表 2. 合同セッション」に回ることもありますので、あらかじめご了承下さい。

◆分科企画シンポジウム

開催日	タイトル	世話人(所属)	一般講演
9/17(水)	7.ビーム応用 X線反射率、表面X線散乱による埋もれた界面の解析における位相問題 - 新光源への期待	桜井 健次 ( 物材機構 ) 寺岡 有殿 ( 原子力機構 ) 江島 丈雄 ( 東北大 )	10
	13.半導体A(シリコン) 絶縁膜上におけるIV族系半導体結晶薄膜の低温成長 - 新しい結晶成長技術への期待 -	佐道 泰造 ( 九大 ) 角田 功 ( 熊本高専 ) 河本 直哉 ( 山口大 )	6
	16.非晶質・結晶 薄膜シリコン太陽電池技術の現状と課題	大平 圭介 (北陸先端大) 松井 卓矢 ( 産総研 ) 伊藤 貴司 ( 岐阜大 )	6
	17.ナノカーボン Japan-Korea Joint Symposium on Semiconductor Physics and Technology - Nano-carbon materials including graphene - (日韓共同シンポジウム - グラフェン等のナノカーボン材料 -)	徳光 永輔 (北陸先端大) 前橋 兼三 ( 阪大 ) Yongmin Kim (Dankook Univ.) 鈴木 哲 ( NTT ) 小林 慶裕 ( 阪大 )	3
	1.応用物理学一般 学生の育成を兼ねた科学啓発活動	渡部 智希 (北海道薬大) 鈴木 芳文 (九州工大)	5
9/18(木)	6.薄膜・表面 12.有機分子・バイオエレクトロニクス バイオマテリアル表面のマイクロナノの挙動とその応用	安江 常夫 (大阪電通大) 山元 隆志 ( 東レ ) 吉越 章隆 (原子力機構) 住友 弘二 ( NTT )	3
	6.薄膜・表面 固液界面を使った新しい酸化物エレクトロニクス: 化学とデバイスの融合	高橋 竜太 ( 東大 ) 神吉 輝夫 ( 阪大 ) 廣瀬 靖 ( 東大 ) 組頭 広志 (高エネルギー加速器研究機構) 田中 秀和 ( 阪大 ) 秋永 広幸 ( 産総研 )	2
	7.ビーム応用 原子・分子ビームによる表面反応制御とその応用展開	寺岡 有殿 (原子力機構) 田川 雅人 ( 神戸大 )	6
	8.プラズマエレクトロニクス コンピュータによるプラズマシミュレーションの実際 (いま、何をどこまで計算できるのか)	高橋 和生 (京都市織大) 豊田 浩孝 ( 名大 ) 小田 昭紀 (千葉工大)	1
	10.スピントロニクス・マグネティクス スピントロニクス材料・デバイスの最前線	関 剛斎 ( 東北大 ) 千葉 大地 ( 東大 ) 好田 誠 ( 東北大 ) 新田 淳作 ( 東北大 )	2
	17.ナノカーボン 機能性原子薄膜化合物材料の新展開	安藤 淳 ( 産総研 ) 吹留 博一 ( 東北大 ) 田中 文士 ( 産総研 ) 塚越 一仁 (物材機構)	7
	1.応用物理学一般 応用物理に期待される資源リサイクルとエネルギー問題	小栗 和也 (東海大) 内田 晴久 (東海大) 藤井 克司 ( 東大 ) 岸田 俊二 ( NEC )	7
	2.放射線 原子力発電所事故時に於ける核燃料・核分裂生成物の挙動及び廃止措置に向けた取り組み	越水 正典 ( 東北大 ) 上野 克宜 (日立製作所) 佐藤 泰 ( 産総研 )	2
	3.光・フォトニクス 量子計測技術における新展開	根本 香絵 (情報学研究所) 仙場 浩一 ( NICT ) 廣川 真男 ( 岡大 ) 小坂 英男 ( 横浜国大 ) 行方 直人 ( 日大 )	6
	6.薄膜・表面 放射光表面反応観察の新展開(仮題)	高桑 雄二 ( 東北大 ) 大野 真也 ( 横国大 ) 吉越 章隆 (原子力機構)	数件
9/19(金)	6.薄膜・表面 12.有機分子・バイオエレクトロニクス Innovation in R&D of the Flexible Electronics -Toward the Inorganic Flexible Devices-	田中 勝久 ( 京大 ) 中村 吉伸 ( 東大 ) 土屋 哲男 ( 産総研 ) 鈴木 基史 ( 京大 ) 金子 智 ( 神奈川産業技術センター ) 西川 博昭 ( 近畿大 ) 岩田 展幸 ( 日大 ) 遠藤 民生 ( 三重大 ) 未定	4
	15.結晶工学 窒化物半導体特異構造の科学 ~物性評価と結晶学の構築へ~	三宅 秀人 ( 三重大 ) 熊谷 義直 ( 農工大 ) 片山 竜二 ( 東北大 )	13
	◆シンポジウム		
	開催日	タイトル	世話人(所属)
9/17(水)	13.半導体A(シリコン) 界面ナノ電子化学: 半導体ウェットプロセスの最前線	矢野 大作 (オルガノ) 真田 俊之 ( 静岡大 ) 吉田 勇貴 ( 関東化学 )	7

◆シンポジウム

開催日	タイトル	世話人(所属)	一般講演
9/17(水)	13.半導体A(シリコン) 界面ナノ電子化学: 半導体ウェットプロセスの最前線	矢野 大作 (オルガノ) 真田 俊之 ( 静岡大 ) 吉田 勇貴 ( 関東化学 )	7

## 2. 講演奨励賞

応用物理学の発展に貢献しうる優秀な論文を発表した若手会員(発表年月日以降の4月1日時点で満33歳以下)に対して「講演奨励賞」が授与されます。応募される方は、登壇申込の申請希望欄の「申請する」を選び該当箇所を入力して下さい。

プログラムに講演奨励賞申請講演である旨が明示されます。講演奨励賞の詳細については次頁を参照して下さい。

## 3. 一般講演投稿要領

### 3.1 登壇資格

一般講演(口頭講演,ポスター講演)の登壇者は応用物理学会の正会員,学生会員に限ります。なお,APS(American Physical Society), EOS (European Optical Society), EPS(European Physical Society), IOP(Institute of Physics), KPS(Korean Physical Society), OSA(Optical Society of America), PSROC(The Physical Society of Republic of China), SPIE,OSK(Optical Society of Korea), Taiwan Photonics Society (TPS), フランス物理学会(SFP), 日本物理教育学会の会員は,応用物理学会正会員扱いとなります。

一般講演における会員1人あたりの登壇件数は口頭講演とポスター講演をあわせて原則3件までとします。4件以上の登壇を希望する場合は,受理の判断材料として,各予稿の内容に重複がない旨の説明書を投稿(切日迄)に提出して下さい。説明書の書式は自由ですが,簡潔に説明して下さい。

### 3.2 登壇申込締切時間

**登壇申込締切: 2014年6月12日(木) 17:00(厳守)**

### 3.3 申込先

登壇申込

URL: <http://meeting.jsap.or.jp/entry.html>

## 4. 予稿原稿(PDF)執筆要領

講演予稿原稿は,講演会参加者に予め講演の内容を知らせ,あるいは講演を聴けない人にもその概要を知らせる重要なデータベースです。受理された予稿原稿ファイル(PDF)がそのままDVD-ROMに収録されます。以下の要領に従って読みやすく理解しやすい予稿原稿を,日本語あるいは英語で作成して下さい。なお,連名の場合には,著者全員の承諾を得て下さい。また,勤務先(研究場所)などからも必要な承諾を得て下さい。

タイトル 著者・所属・E-mail
1段組若しくは2段組で作成して下さい。図表はカラーで作成いただいても結構です。予稿はカラーで表示されません。
予稿は1ページで作成して下さい。

- ① 題目:「について」を省く,「その一,その二」は「I, II」にするなど,簡潔にして要を得た題目にして下さい。また,英文を併記して下さい。
- ② 勤務先(研究場所)・氏名:勤務先(研究場所)は略称を用いるなどして簡潔に表現して下さい。また,英語名称を併記して下さい。
- ③ 登壇者等のE-mail:登壇者・連絡責任者のE-mailアドレスをできるだけ記入して下さい。ホームページがあればそのアドレスも記入して下さい。

- ④ 本文:講演の要旨(原著であること)とそれを得るに至ったデータの中で特に必要と考えられるもののみを記入して下さい。重要な内容に読者が注目できるよう,優先順位を考慮しながら記載して下さい。本文が日本文の場合も**図表とその説明文は英文を使用して下さい。**
- ⑤ その他作成上の注意:登壇申込のwebサイトに掲載されているテンプレートを使用して作成して下さい。

## 5. 予稿原稿(PDF)の取り扱い

- ① プログラム編集委員会で申込希望分科に沿ってプログラムを編成します。**ただし,プログラム編成の都合により登壇申込時の発表分科を変更いただくことがあります。**
- ② 講演番号通知: E-mailでお知らせします(7月上旬)。プログラムの詳細は本会ホームページ(7月中旬)および機関誌「応用物理」8月号に掲載します。
- ③ 作成された原稿をAdobe Readerで閲覧し,文字化けがないことを確認して下さい。すべてのフォントの「埋め込み」を必ず行って下さい。
- ④ DVD-ROMに収録された予稿の著作権は公益社団法人応用物理学会に帰属します。また,同予稿はそのままの形で国立情報学研究所のデータベースに収録されます。
- ⑤ 予稿原稿は講演会WEBプログラムに掲載されます。
- ⑥ 予稿原稿および講演申込部分の記載内容に関する責任は著者が負うものとします。
- ⑦ **投稿締切後の予稿原稿および登壇申込部分の書き換え,あるいは取り下げは一切認められません。**
- ⑧ 応用物理学(広義の)に関する内容以外を含むもの,一般講演投稿要領,予稿原稿執筆要領あるいはインターネット電子投稿要領を著しく逸脱するもの,あるいは本会の品位と信用を損なう恐れがあるものと判断される講演申込は受理しません。

## 6. インターネット電子投稿要領

※講演発表者は**3.1 登壇資格**を確認の上,非会員の方は入会手続と入会支払を済ませて登録して下さい。

※申込締切間際は,大変な混雑が予想されます。できるだけ早い時期の申込をお願いします。

登壇申込についての問合せ先

E-mail: [jsap-meetings@gakkai-web.net](mailto:jsap-meetings@gakkai-web.net)

### <注意事項>

- ・発表形式は「ポスター講演」「口頭講演」「どちらでも良い」のいずれかを選択して下さい。なお,決定はプログラム編集委員会でを行います。
- ・登録が正常に受け付けられると,登録完了画面が表示され,「登壇ID」と「登壇パスワード」が発行されると同時に電子メールでも登録確認メールが配信されます。今後の登録内容の確認・修正やPDF送信等に必要ですので,**画面をプリントアウトして必ず保管して下さい。**
- ※登録完了画面から,続けて予稿原稿のPDFファイルを送信するボタンがあります。
- ・電子メールの受信を必ず確認して下さい。電子メールが届かない場合は正常に登録されていない可能性があります。電子メールが届かない場合は,ホームページの“よくあるご質問”をご確認下さい。
- ・ファイルサイズが**700KB**を超えるファイルは送信することができません。
- ・PDF送信は,必ず登壇申込の手続きを済ませてから行って下さい。
- ・PDFファイルにはセキュリティ設定をかけないで下さい。
- ・登壇申込締切までに予稿PDF原稿が送信されていない場合は**取り下げとします。**

### <登録内容の確認・修正>

登録済の講演内容は、**締切日(2014年6月12日(木)17:00)**迄は確認・修正が可能です。

### <PDFファイルの差替え>

一度送信された予稿原稿は、**締切日(2014年6月12日(木)17:00)**迄は差替えることができます。

### <登壇の取消>

登録済の登壇申込内容は、**締切日(2014年6月12日(木)17:00)**迄は取消が可能です。

## 7.発表形式(一般講演)

### 7.1 口頭講演およびショート口頭講演

パソコンからのプロジェクター投影によるプレゼンテーションです。パソコンは共通仕様の物を学会で用意します。OSはWindows7 Pro, プレゼンテーションソフトはMicrosoft Power Point 2007を予定しています(持ち込みのパソコンも使用できます)。

### 7.2 ポスター講演

備え付けのパネル(1講演につき、**縦180cm,横90cm**)に各自が用意したポスター、図表、写真などを適宜レイアウトして貼り付け、展示時間内で質疑応答を行います。

## 8.講演時間(一般講演1件あたり)

### 8.1 口頭講演

持ち時間15分(講演10分, 質疑応答5分)

### 8.2 ポスター講演

持ち時間2時間(コアタイム; 講演番号の順番が奇数の方は前半1時間, 講演番号の順番が偶数の方は後半1時間)

### 8.3 ショートプレゼンテーション付ポスター講演

ショート口頭講演2分(質疑応答なし)とポスター講演

## 第37回応用物理学会「講演奨励賞」公募会告

応用物理学会は春秋講演会において、応用物理学の発展に貢献しうる優秀な一般講演論文を発表した若手会員に対し、以下のとおり「講演奨励賞」を贈ることによりいたしております。多数の方々への応募を期待いたします。

### 受賞対象者

2014年(平成26年)第75回応用物理学会秋季学術講演会で応用物理学の発展に貢献しうる優秀な一般講演(ポスターセッションを含む)を発表した本会会員であり、以下の資格を有する者。

なお、毎回の受賞論文件数は一般講演件数の原則1%以内と定められています。

- (1) 発表年月日以降の4月1日時点で満33才以下の者
- (2) 論文の筆頭著者であること
- (3) 登録された登壇者であり、かつ実際に登壇した者
- (4) 講演申込時に講演奨励賞を申請(ただし各回1人1件に限る)した者

### 申込手続き

講演申込(web)の所定の入力欄に講演題目、氏名、所属、生年月日、論文の成果の位置付け、特筆すべき点など必要項目を入力して申し込んで下さい。

### 贈呈式

2015年春季講演会期間中に行います。受賞者には賞状と記念品を贈呈いたします。

### 受賞記念講演

2015年春季講演会期中に行います。受賞者には別途ご案内いたします。

### 申込期限

登壇申込締切: 2014年6月12日(木)17:00

### URL

<http://meeting.jsap.or.jp/entry.html>

1. 本規程は公益社団法人応用物理学会が若手会員に対して行う表彰に関して定めたものである。

2. 本表彰は、本会の春秋講演会において、応用物理学の発展に貢献しうる優秀な一般講演論文を発表した若手会員に対し「講演奨励賞」を授与し、その功績を称えることを目的とする。

3. 表彰対象は本会の春秋講演会で、応用物理学の発展に貢献しうる優秀な一般講演論文(ポスターセッション論文を含む)を発表した本会会員であり、かつ本講演奨励賞をまだ受賞していない者であって、以下の資格を有する者とする。

- (1) 発表年月日以降の4月1日時点で満33才以下の者
- (2) 論文の筆頭著者であること
- (3) 登録された登壇者であり、かつ実際に登壇した者
- (4) 講演申し込み時に、講演奨励賞を申請(ただし各回1人1件に限る)した者

4. 論文発表者で、会員外(分科会A会員, 相互協定を締結した外国学協会の会員, 共催学協会会員, および非会員)の者は表彰対象としない。

5. 受賞者は半年後の本会の春秋講演会において表彰するとともに、表彰対象者の一覧表を掲示する。

6. 受賞者には会長名の賞状を授与し、記念品を贈呈する。

7. 表彰は表彰時点における公益社団法人応用物理学会会長名により行う。

8. 講演奨励賞委員会は春秋講演会において、表彰の対象となる論文を原則として一般講演件数の1%以内を限度として選び、推薦理由を付して理事会に推薦する。

9. 理事会は講演奨励賞委員会の結果を審議し、受賞者を決定する。

10. 理事会は受賞者決定後すみやかに該当者に通知し、かつ会誌に公示する。

11. 本規程は理事会の承認を経て改定することができる。

### 付 則

1. この規程は平成8年2月23日理事会にて決定。

2. この規程は平成8年4月1日より施行する。

平成19年11月20日一部変更

## 講演奨励賞規程

- この規程は、公益社団法人応用物理学会（以下「本会」という。）が本会会員に対して行なう Poster Award に関して定めたものである。
  - Poster Award は、本会の応用物理学会春季学術講演会および応用物理学会秋季学術講演会（以下「講演会」という。）において、応用物理学の発展に貢献しうる優秀なポスター講演を行った会員を表彰し、その成果を称えることを目的とする。
  - 表彰対象は、本会の講演会で発表された、応用物理学の発展に貢献しうる優秀なポスター講演で、以下(1)～(2)の条件を全て満たす著者を表彰する。
    - ポスター講演を行った時点で本会会員であること
    - 講演申し込み時に、登録された著者であること
  - ポスター講演の著者で、会員外(分科会 A 会員, 相互協定を締結した学協会の会員及び非会員)の者は表彰対象としない。
  - Poster Award の選考手順は、別途内規で定める。
  - 表彰の対象となるポスターは、ポスター講演総数の概ね 2% 以内とする。
  - 受賞者には本会会長名の賞状を授与する。
  - 表彰は表彰時点における本会会長名により行う。
  - 受賞ポスターは、講演会会期中、会場に掲示する。
  - 表彰されたポスターについては、選定理由を付して講演会企画運営委員会及び理事会に報告する。
  - 本規程の改正は総務委員長が承認し理事会へ報告する。
- 付 則
- この規程は平成 25 年 2 月 15 日理事会にて決定。
  - この規程は平成 25 年 2 月 15 日より施行する。

#### <受賞対象>

2014 年(平成 26 年)第 75 回応用物理学会秋季学術講演会において実際に実施されたポスター講演

#### <選考方法>

##### step1)会場審査

講演当日、ポスター世話人が「ノミネート候補」となったポスター講演の内容を講演開始 30 分間で精査し、最終的な選考対象を決定します。

##### step2)投票・選出

選考対象ポスターについて、講演会企画運営委員長・副委員長およびポスター世話人を含む選考委員会で受賞ポスターを選出します。

- ・ノミネート候補となった方には事前にお知らせしますので、講演会当日は開始前にポスターの貼付を完了し、セッション開始 30 分間はポスターの前から離れないようお願いいたします。
- ・最終的な選考対象として選定された場合は、当日の発表者に通知いたします。受賞者には表彰状を授与いたします。(授与時期未定)
- ・Poster Award の表彰対象は、本会正会員（学生会員を含む）になりますので、表彰を希望される場合は、ポスター講演時までに、入会手続きをお願いします。

# 登壇申込締切:2014 年 6 月 12 日(木)17 時

## 一般講演で登壇するための 3 つのステップ

### 1.入会登録

※※非会員のみ※※

#### 一般会員

入会金 10,000 円  
年会費 10,000 円

#### 大学生・大学院生

入会金 6,000 円  
年会費 6,000 円

※初年度は年会費無料

### 2.登壇申込

締切:6 月 12 日(木)17:00

締切以降の取消,差替え  
修正は一切受け付けて  
おりませんのでご注意ください。

### 3.参加申込

#### 事前予約

一般会員 8,000 円  
学生 3,000 円  
非会員 15,000 円

#### 当日受付

一般会員 12,000 円  
学生 5,000 円  
非会員 20,000 円

今大会より、会員の方は会員マイページからのお申込みに変更になります。未納の会費がある場合には、お支払いが確認でき次第、お申込みが可能になります。